高エネルギー将来計画委員会: 第7回 勉強会 / THz加速、誘電体加速

2021.01.27

KEK加速器:吉田光宏, 張 叡,周 翔宇,本田洋介,森 伸悟 分子研/理研:平等 拓範,石月 秀貴, Arvydas Kausas, Yahia Vincent

超高電界加速の方式

加速器の電界を大幅に上げるには

・ 耐圧の高い媒質
$$W(蓄積エネルギー) = \int \frac{\varepsilon E^2 + \mu H^2}{2} dV$$

- ×金属
- ◎プラズマ
- ○誘電体

$$E = \sqrt{\frac{2W}{\varepsilon V}} \sim f\sqrt{W}$$

E:電界、H:磁界 V:体積

f: 周波数

• <u>体積を小さくする</u> or <u>蓄積エネルギーを上げる</u>

周波数の高い加速器: THz

- 従来のGHz帯加速方式
 - → 20GHz以上の高周波源が無い
- 周波数重畳
- 100 fs 程度の超短パルスと プラズマ or 誘電体による変換

Q値の高い材料

- 常伝導Cu: Q~10,000
- 超伝導Nb: Q~10¹⁰ しかし電界<40MV/m
- 誘電体 : Q~10⁶
- ・レーザー駆動 レーザー高強度化は著しく速い
- 電子ビーム駆動 SLAC/KEK等で可能&世界最高電圧の実績
- ・陽子ビーム駆動 CERN/J-PARC等で可能→バンチ圧縮が問題

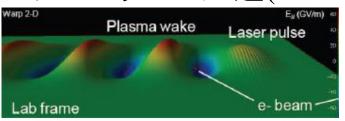
両方を併せ持つような超高電界加速が望まれる

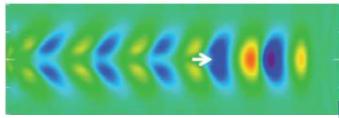
- → Q値(Enhancement Caviy 等)で上げられればレーザー
- への要求性能は極端に下がる

超高電界加速方式

レーザー駆動加速器

レーザープラズマ加速(LWFA)

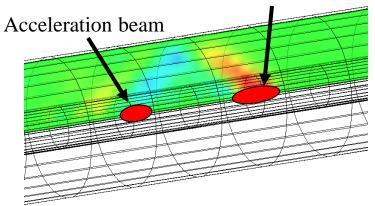




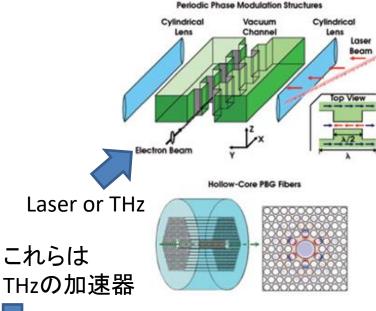
ビーム駆動加速器

誘電体加速(DWA)

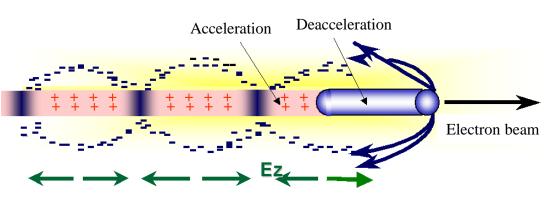
Drivé beam



レーザー誘電体加速



プラズマ加速 (PWFA)

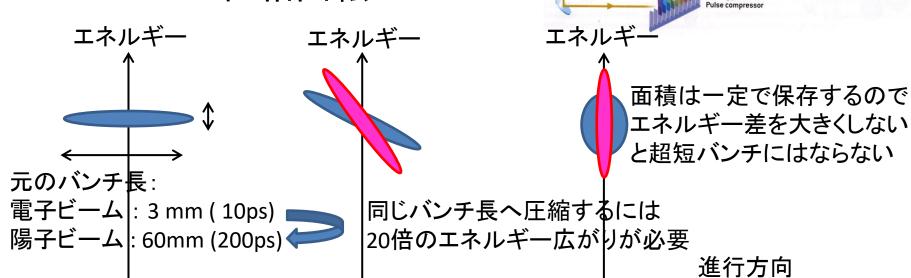


超短パルスを作るための圧縮

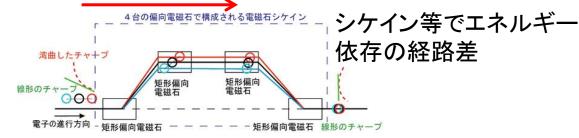
バンチ圧縮には エネルギー差が必要

- レーザー: CPA(チャープパルス増幅)

- ビーム:位相回転



傾きを付けるための高周波加速



stretched pulse

Pulse stretcher

エネルギー源と電界

	常伝導	超伝導	電子ビーム 駆動	レーザー 駆動	陽子ビーム駆動
	6/12GHz	1.3GHz	5THz (50fs)	5THz (50fs)	? THz (後述)
駆動エネルギー	20J [/m] = 40MW × 500ns	200J [/m] = 300kW × 700μs	70J (SLAC) =23GeV × 3nC 35J (KEK) =7GeV × 5nC	40J (→ 1kJ)	15kJ (SPS) = 450GeV × 30nC 150kJ (LHC) = 7TeV × 20nC 300kJ (J-PARC MR) = 40GeV × 8μC
電界	40/80MV/m 放電限界	40MV/m クエンチ	20GV/m × 2m = 40 GV	10 GV/m	?
繰り返し	50Hz	5Hz	50Hz	10Hz	1/18 Hz (SPS) 0.3 Hz (J-PARC MR)
ビーム電力 /駆動/AC	400W / 1 kW / 8 kW (1m辺り)	10 MW / 23 MW / 150 MW (ILC)	? / 3.5 kW / 70 kW	4 W ? /400W /4kW(LD)	? / 833W/75MW (SPS) / <u>300kW/25MW</u> (J-PARC)
効率	5% ?	8%	5%(電子生成) ×η(e→e)	現状 0.1 % → 10 %?	1%(陽子ビーム生成) × η(p→e)

加速器と高電界加速への展望

常伝導加速器 LCLS 120Hz SACLA 60Hz





超伝導加速器 (高繰り返し)

Euro-XFEL 27 kHz

LCLS-II 300 kHz





小型化のための高電界加速の候補:

レーザープラズマ加速

ビーム駆動プラズマ加速

レーザー駆動THz 加速

ビーム駆動THz加速

> 100GV/m だが、繰り返しを上げる方法

超伝導加速器駆動 (Flash Forward)

<1 GV/m

>10 GV/m

THz-Enhancement Cavity で

バーストモードが可能

THz加速の有効性

- THz の誘電体加速 12 GV/m が World Record 実用上は 1 GV/m 程度が利用しやすい (加速器の全長が 1/30 になるので十分高い電界)
- 共振器を形成可能
 →マルチバンチによる大電流ビームの加速が可能
 (高繰り返しレーザーが無くても多バンチを加速可能)
- 装置が簡単 (ガラスの筒しかない)
- プラズマ加速と比べて追加速に利用し易い 超高真空に対応/収束力の問題が無い/散乱無
- THz 加速器の KEK/分子研/理研での実証試験
- ・ビーム駆動による 追加速の実証実験

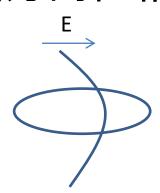
分子研・理研との協力による 高強度THz源開発

レーザー加速で必要な加速パラメーター

パルス幅 ~300fs (位相空間から) バースト (効率から)

ビームの位相空間 → パルス幅(周波数)

• 横方向位相空間



$$\sigma_{x} = \sqrt{\varepsilon_{n}\beta/\gamma}$$

$$\delta_{x} = \frac{\delta p}{p} = 1 - \cos\frac{2\pi\sigma_{x}}{\lambda} \approx \frac{\pi^{2}\sigma_{x}^{2}}{2\lambda^{2}} = \frac{2\pi^{2}\varepsilon_{n}\beta}{\lambda^{2}\gamma}$$

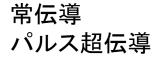
1 GeV, ϵ n=1 μ m•rad, β =1 $m \rightarrow \sigma$ x=20 μ m Energy Spread = 1- ϵ cos($2\pi \sigma$ x/ λ) = 0.01%(λ =10 ϵ mm), 0.4% (λ =1.5 ϵ mm = 2 ϵ ps = 200GHz) 10% (λ =0.3 ϵ mm = 400fs = 1 THz) そもそも 30fs だと位相空間に入らない

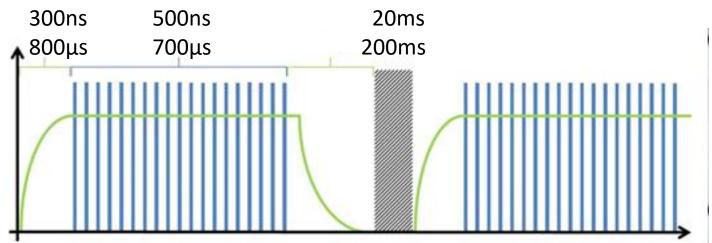
• 縱方向位相空間

$$\delta = \frac{\delta p}{p} = 1 - \cos \omega \sigma_T$$
 $\sigma_T = 30 \text{ fs}$ Energy Spread = 1-cos(ω σ T) $= 0.7\%$ (λ =1.5mm = 2ps = 200GHz) 2 % (λ =0.3mm = 400fs = 1 THz) そもそも 30fs だと位相空間に入らない

加速効率: Accelerator pulsed operation

RF accelerator operates burst micro bunch



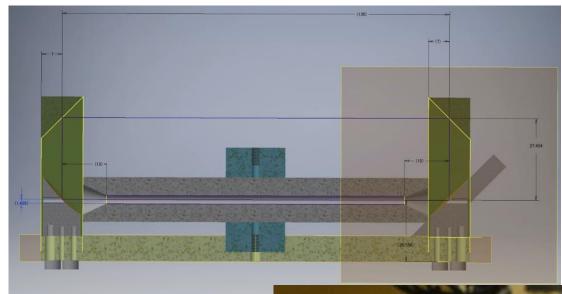


バーストパルスでビームエネルギーへの 変換効率を上げない限り、総合効率は上がらない

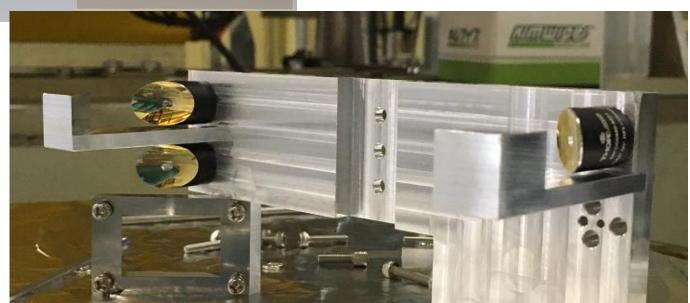
$$\begin{split} & \delta_{x} = \frac{2\pi^{2}\sigma_{x}^{2}}{\lambda^{2}}, \quad q = \pi^{2}\rho\sigma_{x}^{2}\sigma_{t}, \quad I = qN, \quad Q = \frac{\omega U}{P_{loss}} \\ & U = \int \frac{\varepsilon E^{2} + \mu H^{2}}{2} dV \sim \frac{\varepsilon_{0}E^{2}\lambda^{2}\pi^{2}}{8} L \\ & P_{beam} = \int IEdz = IEL = \rho \frac{\delta_{x}\lambda^{2}}{2} \sigma_{t} NEL \\ & \eta = \frac{P_{beam}}{P_{loss}} = \frac{8Q\rho\delta_{x}\sigma_{t}N}{\pi^{2}\varepsilon_{0}\omega E} \end{split}$$

Parameter	ILC	FLASH	Euro XFEL	
Energy	250 GeV*2	1.2 GeV	17.5 GeV	
Length	31 km	200 m	1500 m	
Cavity type	9-cell TESLA-type SSCs			
Resonance frequency	1300 MHz			
Cavity gradient (MV/m)	31.5±20%	20	23.6	
Loaded Q	3e6 ~ 10e6	~3e6	~3e6	
Number of cavities (e-,e+,RTML,ML)	15,814	42	928	
Cavities per klystron	39	16	32	
Number of klystrons	378	5	29	
Beam pulse length	727 us	650 us	650 us	
Beam current	5.8 mA	3 mA	5.0 mA	

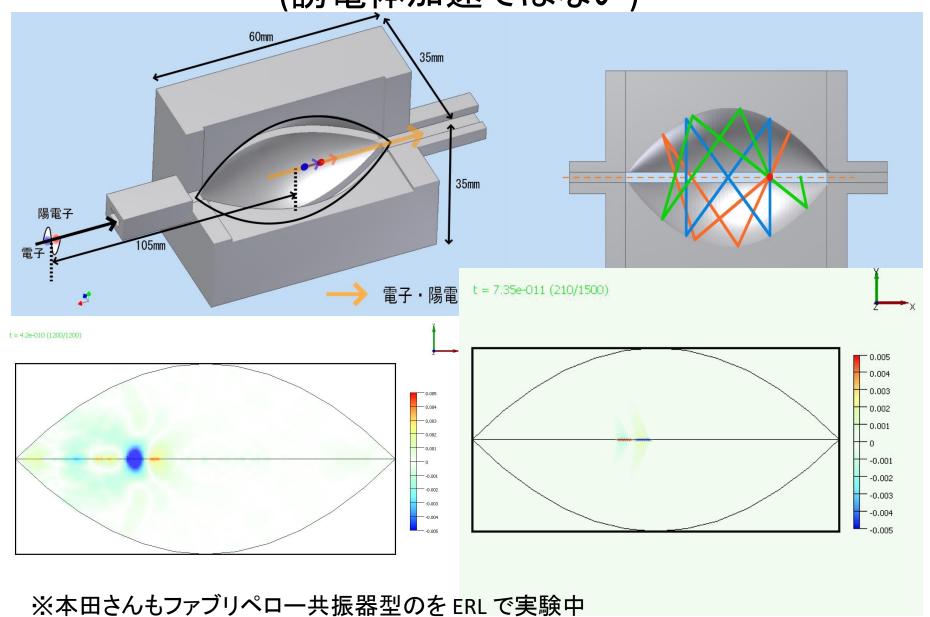
共振型 DLW の試験 穴径Φ2mm, 100GHz帯



KEK-LINAC に インストール済



THz帯周波数重畳 = モードロック加速管 (誘電体加速ではない)



誘電体加速/THz-DLW

THz- Dielectric Lines Waveguide ※ただのガラス管です

誘電体加速

Dielectric Laser Acceleration (DLA):

グレーティング構造に電磁波を照射して 表面を走行する電子を加速する方式

表面で近119の電子で加速9の万式 1μm帯: 東大(上坂研)との共同開発(科研費)

THz帯: 分子研(平等研)・理研(南出研)との共同開発

<u>Dielectric Lined Circular Waveguide (DLW):</u>

キャピラリー中のTHzで加速

<u>ビーム駆動</u>: 超短パルス電子ビームを通す際に生じる 超高電界のTHz航跡場で後続のビームを加速(東大との協定)

<u>レーザー駆動</u>: THz-PPLN で生成した高強度 THz

産業技術総合研究所で実験 → 現在KEK/分子研・理研(平等研)

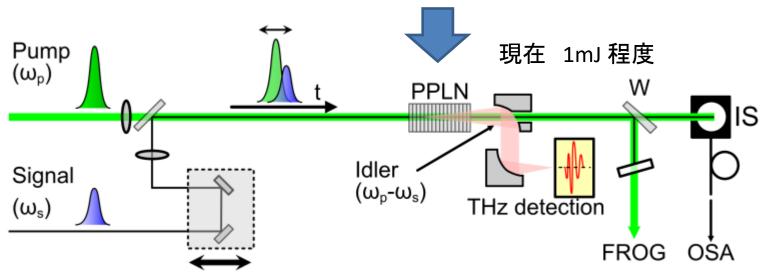
Dielectric Wall Accelerator (DWA)

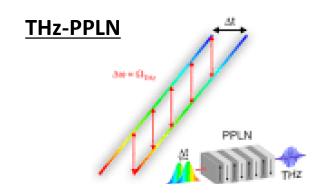
光伝導スイッチ(PCSS)を用いて誘電体伝送路 を高速にスイッチして加速電界を得る 東芝との共同研究中

Dielectric Assisted Accelerator (DAA) 誘電体装荷型加速管 高いQ値 (10⁵@室温•10⁸ @ 80K) 6 GHz /12 GHz:科研費•三菱重工/基本特許取得

世界的な動向: DESY(F. Kartner)

分子研製のPPLNを使用



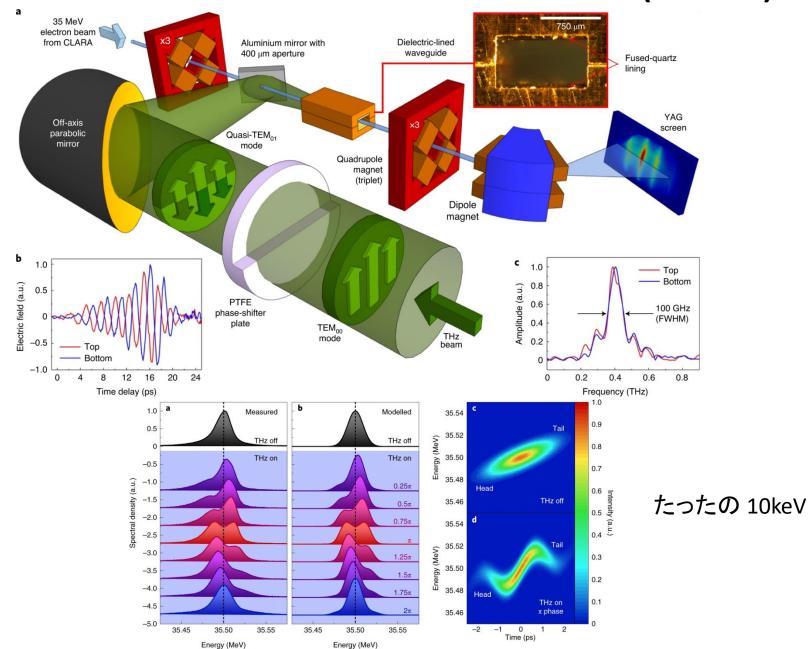


マンレーロー限界を越えるためにはカスケーディングが必須

hv (300THz) hv (300GHz)

- MgO:PPLN: Pole=212μm, 10x20x L=40mm (damage threshold: 1 J/cm²)
- τ =1ps, $\Delta t \sim$ 1ps

世界的な動向: Nature Phtonics(2020)



THz帯DLA 用 Si 回折格子(KEK初期の実験)

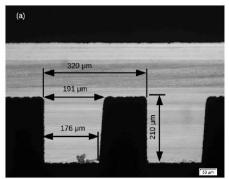
THz 光の加速器の利点:

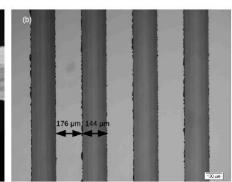
- 0.1 mm 程度の加速構造
 - ·加速領域の体積が赤外のおよそ 100³倍
 - ・加速構造の機械加工が可

光(赤外)に近い高い加速勾配(絶縁破壊)

· 200 MV/m

THz OI-DLA のための Si 回折格子の加工





ポンプ光 Qスイッチ	→軸ステージ	TPXシリンドリカルレンズ THz波ビーム Siプリズムアレイ
Nd:YAGレーザ		MgO:LiNbO3結晶
注入光 Ybファイバー レーザー		k_p \vec{k}_i

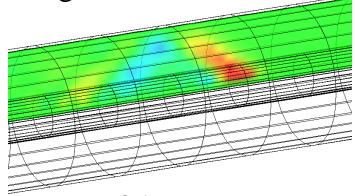
Pitch	0.320	mm
Depth	0.210	mm
Number of Pitches	10	
Material of Wafer	Si	
Thickness of Wafer	0.380	mm
Index of Si @ ~THz	3.4	

DLW

Breakdown Limits on Gigavolt-per-Meter Electron-Beam-Driven Wakefields in Dielectric Structures

M. C. Thompson, ^{1,2,*} H. Badakov, ¹ A. M. Cook, ¹ J. B. Rosenzweig, ¹ R. Tikhoplav, ¹ G. Travish, ¹ I. Blumenfeld, ³ M. J. Hogan, ³ R. Ischebeck, ³ N. Kirby, ³ R. Siemann, ³ D. Walz, ³ P. Muggli, ⁴ A. Scott, ⁵ and R. B. Yoder ⁶

Single-wall DLW:



$$a = 0.1mm$$

$$b = 0.324 \, mm$$

$$\varepsilon = 3.0(SiO_2)$$

$$q = 5 nC$$

$$\sigma_z = 30 \mu m (0.1 ps)$$

13.8 ± 0.7 GV/m. Fused silica, THz range, ~psec exposure

KEK で最大可能なパラメーター

Mode wavelengths

$$\lambda_n \approx \frac{4(b-a)}{n} \sqrt{\varepsilon - 1} = 0.7 \, mm$$

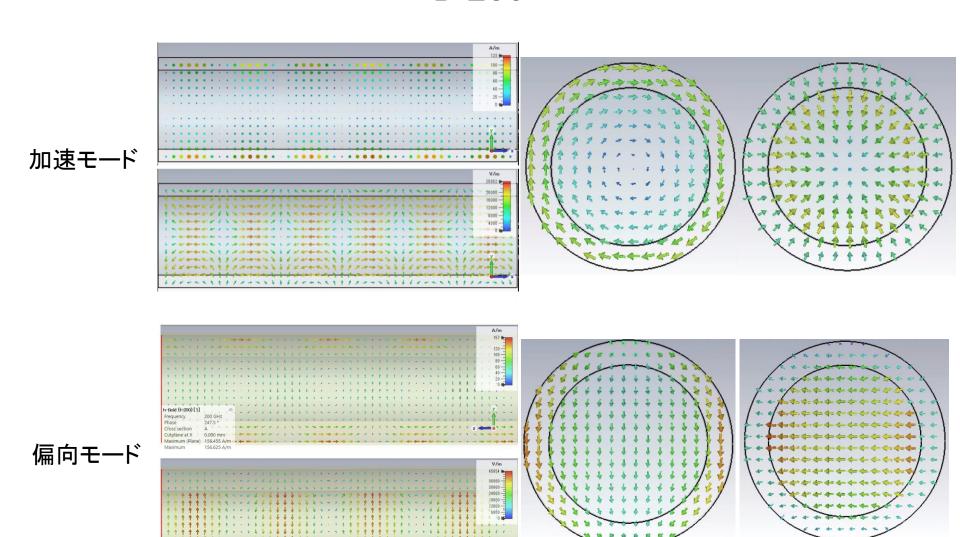
Peak decelerating field

$$eE_{z,dec} \approx \frac{-4N_b r_e m_e c^2}{a \left[\sqrt{\frac{8\pi}{\varepsilon - 1}} \varepsilon \sigma_z + a \right]} = \frac{2GV / m(\sigma_t = 0.1ps)}{a}$$

Transformer ratio

$$R = \frac{E_{z,acc}}{E_{z,dec}} \le 2$$

DLW



さらに円偏波にすれば回転方向にビームをキック可能になります

XFELでのTHz加速への期待

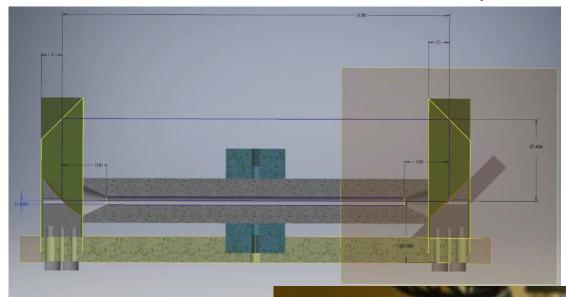
- THz-Deflector によるバンチ長/構造の観測
- バンチ圧縮によるFELゲインの向上
- アト砂バンチ生成
- 超小型XFEL

XFEL: SACLA のバンチ長測定・圧縮してアト秒へ FELパルスと電子ビームの SACLAの尖塔電流は設計値より既にかなり高い 相互相関 電流分布推定值 10° 0.6 Current (kA) 4 fs 10⁻¹ Pulse Energy (mJ) 7.0 7.0 Pulse Enegy (mJ) 10⁻² 2011 Oct 2014 May -10 0 _ 1 _ Time (fsec) $L_{o} = 4.4 \, \mathrm{m}$ $L_{o} = 1.9 \text{ m}$ 10⁻³ $\pm 3.5 \text{ kA}$ Ip = 12 k/A $\Delta t = 20 \text{ fs}$ $\Delta t = 4 \text{ fs}$ 0.3 10⁻⁴ 20 40 60 80 100 120 140 0.1 100 Effective Undulator Length (m) Time Delay (fsec) •THz ディフレクター(直線偏波)による **THz** 電子ビームのアト秒時間分解能での観察(1mJ) RF-deflector $\mathsf{B}_{\mathsf{DEF}}$ beam (y_d, y_d') ・THz誘電体加速器(ラジアル偏光)による (y_s, y_s') バンチ圧縮 → 尖頭電流向上/アト秒電子生成(10mJ)

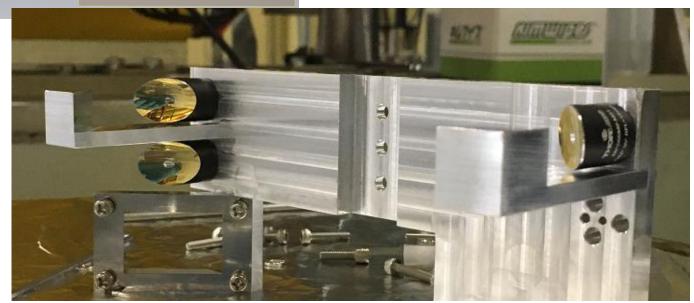
KEK ビーム駆動THz加速

まずは超高電界のTHz加速の実証のため

共振型 DLW の試験 穴径Φ2mm, 100GHz帯

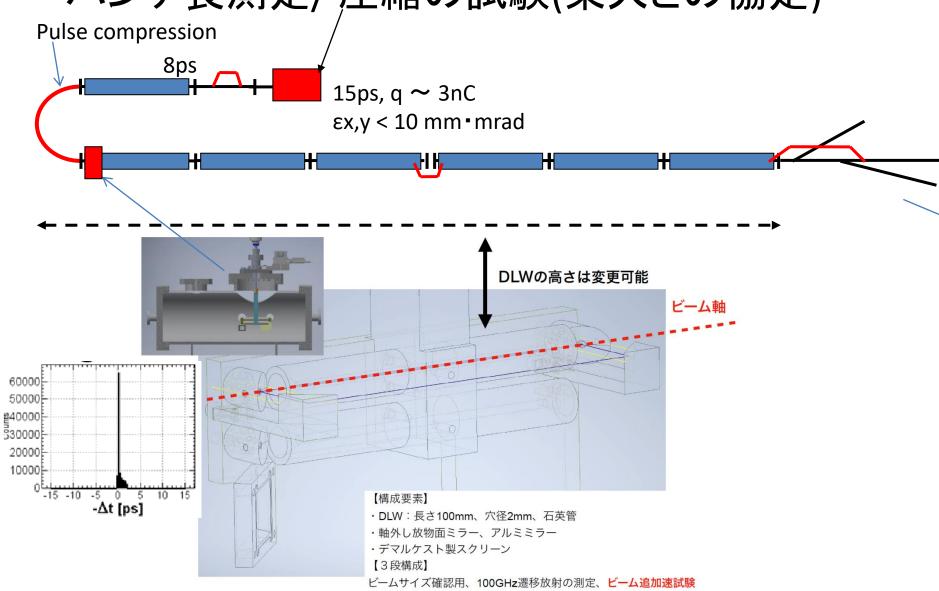


9月インストール済 → 12月に試験

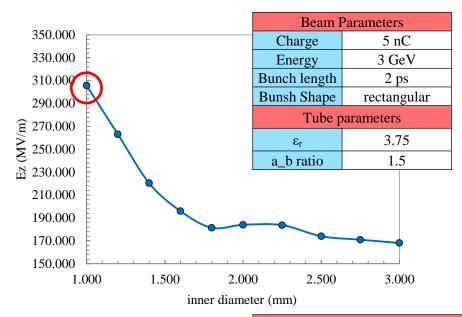


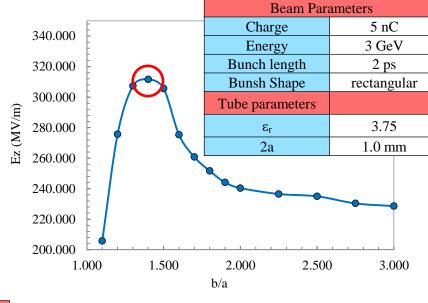
LINAC C-1 での試験スタンド

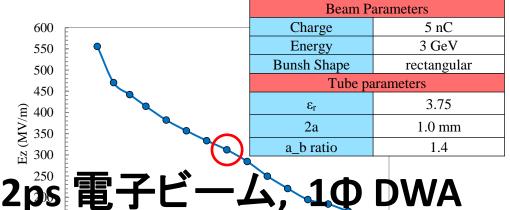
・ バンチ長測定/圧縮の試験(東大との協定)



DLWの加速パラメーター







ミリ波検出器での THz の確認



(国内最高強度の THz放射)

300 MV/m 3.00

KEK/分子研・理研 レーザー駆動THz加速

MgO:PPLN / THz generation

THz-PPLN

PPLN

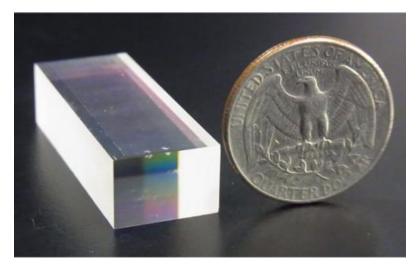
THZ

マンレーロー限界を越えるためにはカスケーディングが必須

hv (300THz)

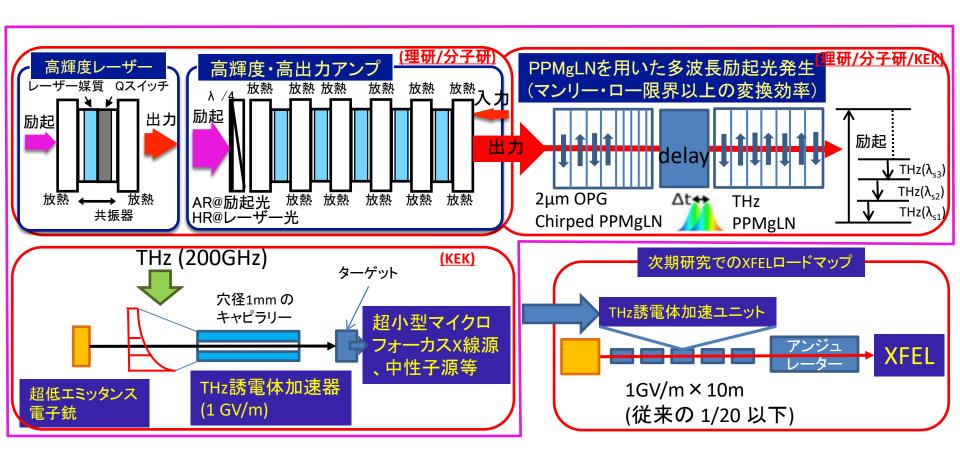
- MgO:PPLN: Pole=212μm, 10x20x L=40mm (damage threshold: 1 J/cm²)
- $\tau=1ps$, $\Delta t \sim 1ps$

分子研製超大型 PPLN



5% 変換効率が得られれば 2J → 100mJ THz が可能なはず

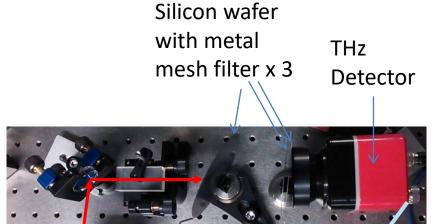
レーザー駆動の THz-DLW

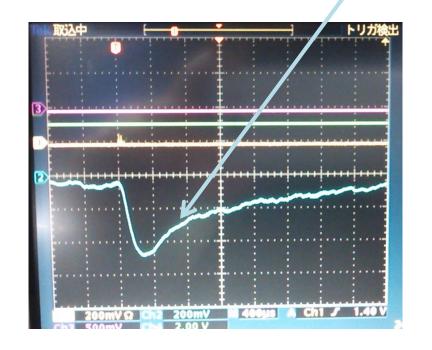


冷却 Yb:YAG / PPLN

分離型ヘッドのパルスチューブを使用 (無振動)







KEKにおけるレーザー開発

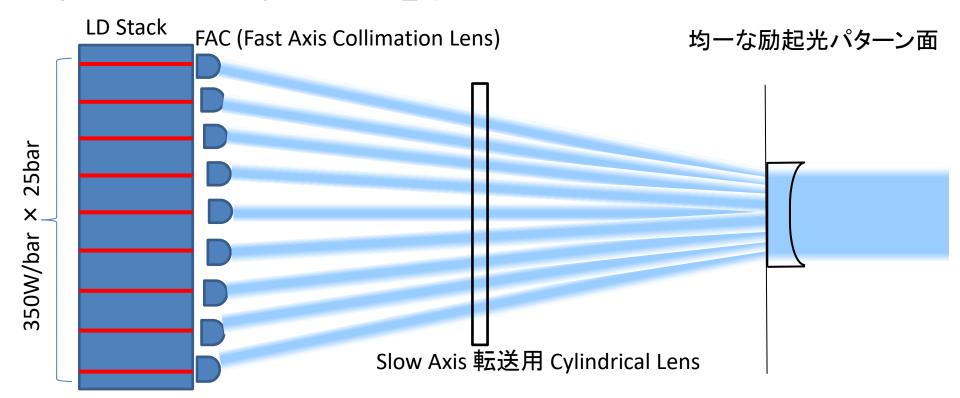
- 全てのレーザーシステムが Multi-pass
 - マルチバンチ / Enhancement Cavity に対応
- Nd系レーザー開発(未来社会創造事業レーザー開発G)
 - 平等件製 DFC を使用
 - 浜松ホトニクス製 885nm 8kW Laser Diode Stack
- Yb系レーザー開発
 - 平等研製 常温接合の Think Disk を使用
 - 浜松ホトニクス製 940nm 9kW Laser Diode Stack
 - 室温 Yb:YAG → 冷却 Yb:YAG
- Ti:Sapphire 系の増強
- 赤外 Chirped PPLN への期待

Laser Diode

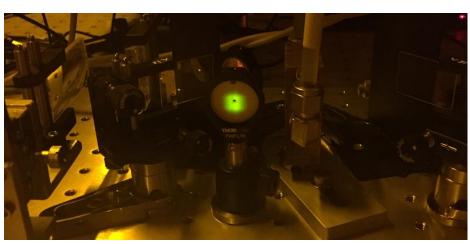
- Laser Diode Stack
 - ×帯域幅 3nm (DB)
 - △ビームパターンを成形する方法が必要
 - QCW(Duty ∼3%) では kW/bar 位まで到達
 - 3% / 100Hz = 300µs (これ以上の蛍光寿命は不要)
 - 25万円/kW×3%=30W(CW) → 1000万円/kW
 - -CW
 - 100万円/kW → 1kHz でも 1ms の蛍光寿命が必要
- Fiber Bundle
 - QCW 50万円/kW, 150万円/kW
- VCSEL
 - ×励起密度低い 150W/chip → Nd:YAG side pump
 - OQCW~CW まで連続
 - 〇狭帯域

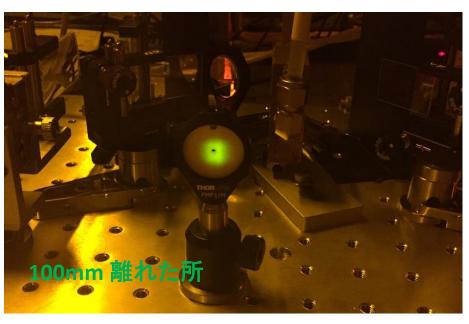
Hamamatsu 製 QCW Laser Diode Stack

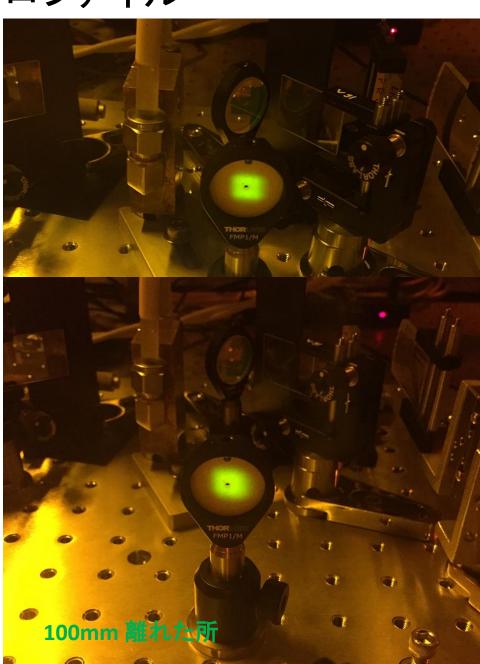
- QCW LD Stack: 30万円/kW (Fiber Bundle の 1/5)
- $350W/bar \times 25bar = 8.75 kW \times 250\mu s > 2J/stack$
- FACの精密アラインメントで均一な励起パターン
- 開発した安価な大電流パルスドライバ



励起光プロファイル

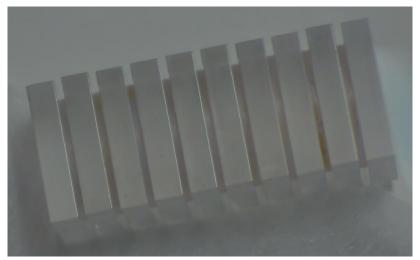


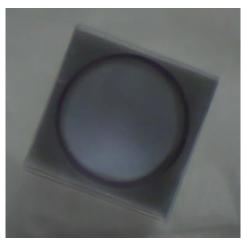




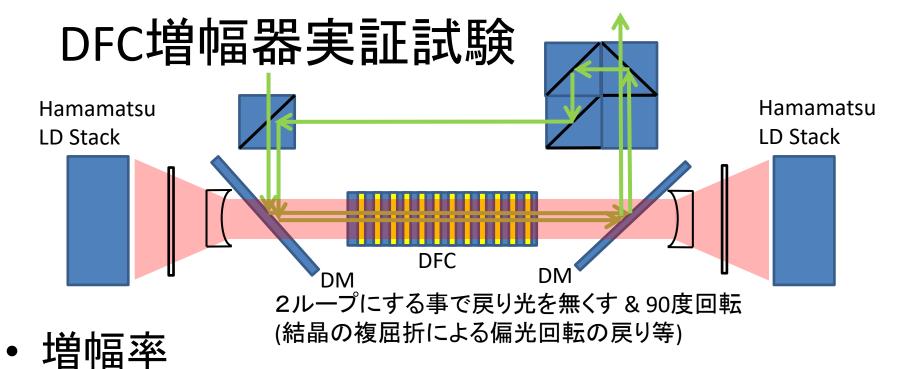
Nd:YAG DFC

• 0.65t x 9 Nd:YAG + 2t x 10 Sapphire = 25mm





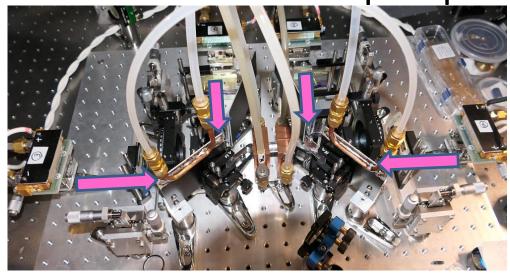


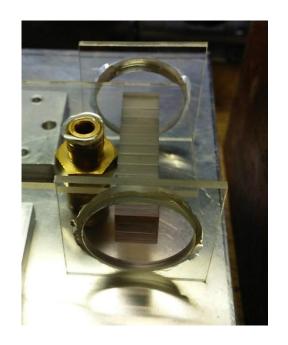


- 8 kW x 4 (両方向On-Axis励起) x 250μs = 8 J / cm²
- G= 5 for L(Nd:YAG) = 1.3cm(1/e²) (2-passで50倍)
- Pump(885nm) Output 4 stack(32kW, 8J) \rightarrow 2 J \rightarrow 1 J @ SHG

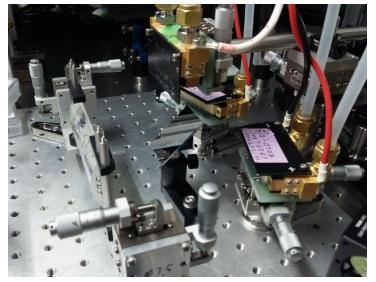
2J Nd:YAG DFC

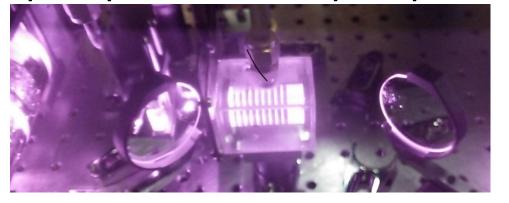
8 kW x 250us x 4 = 8 J pump





• 8 kW x 250us x 3 = 6J pump \rightarrow x 2 12J pump

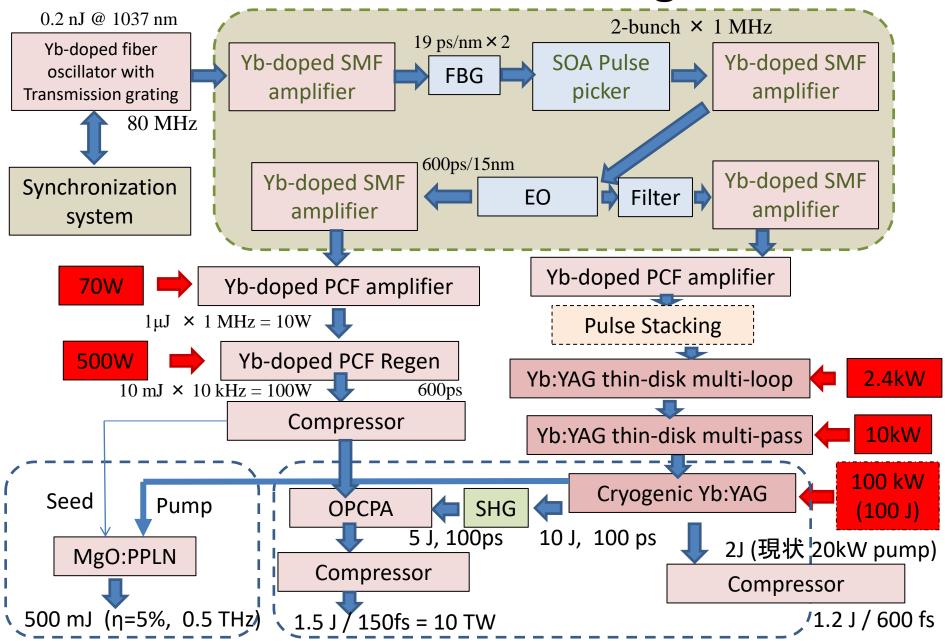






2.4 J ouput (5 Hz)2.0 J output (25 Hz)

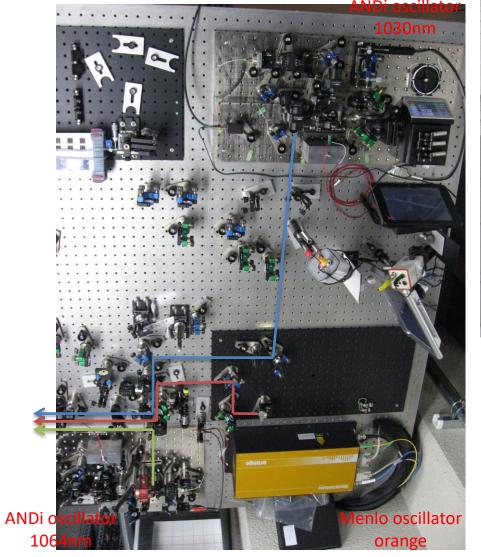
Yb:PCF/YAG + OPCPA + MgO:PPLN

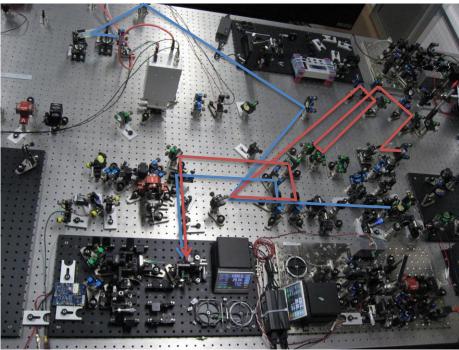


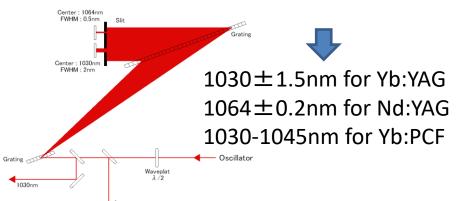
Yb-fiber laser system

1064nm

Oscillators (1025-1065 nm)







まとめと現在の研究活動

- ・ 超高電界の加速方式
 - THz 加速
 - > 数100MV/m, High-Q→マルチバンチ加速が可能 既存加速器との親和性が高い
- そのためのレーザー開発 / THz発生
 - 2J 程度で必要十分, 既に 100Hz 動作まで可能
 - Yb 系レーザーでの実証実験 (~25Hz バースト)
 - Nd系 → Ti:Sapphire(or Chirp PPLN) → THz PPLN
- 研究活動
 - 分子研・理研との協力体制の構築 (既に10年近い)
 - 長年競争的資金の取得に失敗が続いていた
 - 今年から予算獲得して5年で実現予定